

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平6-196494

(43) 公開日 平成6年(1994)7月15日

(51) Int.Cl. ³	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/336 29/784		9054-4M 9054-4M	H 0 1 L 29/78	3 0 1 L 3 0 1 P

審査請求 未請求 請求項の数1(全4頁)

(21) 出願番号 特願平4-342488

(22) 出願日 平成4年(1992)12月22日

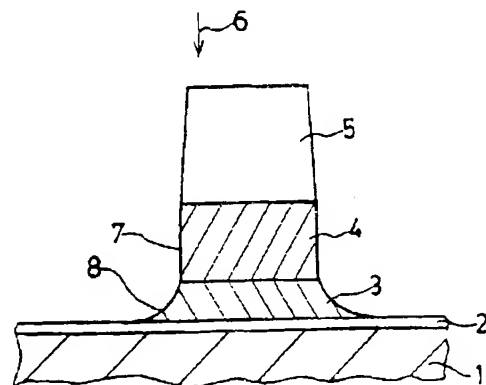
(71) 出願人 000001258
川崎製鉄株式会社
兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号
(72) 発明者 中村 謙二
東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 川崎製鉄株式会社東京本社内
(74) 代理人 弁理士 小杉 佳男 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 LDDトランジスタ構造のゲート電極形成を1回のイオン注入によって実施でき、優れたLDD構造を得る。

【構成】 ゲート電極形成において、基板1、ゲートSiO₂膜2上に最初にポリシリコン3を成膜し、その上にアモルファスシリコン4を成膜し、フォトレジスト5を載せて、このシリコン膜をノンドープのままドライエッチング6を行う。アモルファスシリコン4の側面7は垂直になり、ポリシリコン3の側面8はテーパ状となる。次にイオン注入すれば優れたLDD構造のゲート電極が形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 LDDトランジスタ構造の形成において、最初にポリシリコンを成膜し、引き続きアモルファスシリコンを成膜し、このシリコン膜をノンドープのままドライエッチングし、ゲート電極を形成した後、ゲート及びソース、ドレイン領域に同時に不純物イオン注入を行うことを特徴とする半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はLDDトランジスタ構造 10
を有する半導体装置の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】LDD (lightly doped drain: 低濃度ドープドレイン) トランジスタは、一般に次の工程によって作成されている。

(1) ゲート電極を形成する。

(2) イオン注入により低濃度の、浅いソース・ドレイン領域を形成する。

(3) CVDによって酸化膜デポジションを行う。

(4) 異方性エッチングを行い、ゲート電極側壁にサイドウォールを形成する。このサイドウォールにより、次の工程でイオン注入された領域の横方向拡散の先端部はポリシリコンの位置とサイドウォールの幅によって決まる。

(5) イオン注入によって高濃度のソース・ドレイン領域を形成する。このとき、ゲートは高濃度にドープされたソース・ドレイン領域とオーバーラップせず、ドレイン-チャンネル界面における低い不純物勾配を実現することができる。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術ではイオン注入工程が2回となるほか、サイドウォール形成工程などプロセスが複雑でコストがかかる。またサイドウォール形成の際のSiO₂エッチングによってSi基板の掘れ込みが生じ、これが欠陥層のもとになり、接合リークが発生するという問題があった。

【0004】本発明はこのような問題点を解決し、簡易に、優れたLDDトランジスタを形成する方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、ゲート電極材料の下層をポリシリコン、上層をアモルファスシリコンとし、ノンドープのまま異方性エッチングを行うことによって、上層のアモルファスシリコン層の側壁は垂直に、下層のポリシリコン層の側壁はテーパ形状にエッチングされることを利用している。この際、エッチング条件はマルチステップにする必要はなくアモルファスシリコン層を垂直にエッチングできる条件の1工程のみでよい。

【0006】次にソース・ドレイン領域形成のためNチ 50

ヤネル側にはP⁺あるいはAs⁺を、Pチャネル側にはB⁺あるいはBF₂⁺をイオン注入する。これによりソース・ドレイン形成と同時にゲート電極にも高濃度に不純物を注入することができ、また、ゲート電極のポリシリコン層がテーパ形状となっているため、このソース・ドレインへの高濃度イオン注入を1回だけ行うことによって、LDD構造を形成することが可能となる。

【0007】

【作用】従来方法では、(1) ゲートポリシリコン成膜、(2) 不純物注入及びアニール、(3) ゲート加工、(4) 低濃度イオン注入、(5) サイドウォール形成、(6) 高濃度イオン注入と6工程必要であったが、本発明方法によれば、(a) ゲート(ポリ/アモルファス)シリコン成膜、(b) ゲート加工、(c) 高濃度イオン注入、(d) ゲートエッチング(等方エッチ)と4工程に省略することができる。

【0008】ポリシリコン成膜とアモルファスシリコン成膜は減圧CVD装置により、成膜温度を600℃以上、570℃以下にそれぞれ設定し、成膜途中で変更することにより同一工程において成膜することができる。また、サイドウォール形成におけるSiO₂エッチングを省略することができるので、基板の掘れ込みが生じない。従って、接合リーク欠陥を防ぐことができる。

【0009】

【実施例】ゲート酸化膜上に、減圧CVD装置で、ポリシリコン及びアモルファスシリコン膜を成膜する。このシーケンスを図7に示した。ポリシリコン膜を620℃で1500Å成膜し、ポリシリコン成膜後、炉の温度を550℃に下げることによって、アモルファスシリコンを成膜する。アモルファスシリコンの膜厚は3000Åとする。図1にこれを示すもので、シリコン基板1、ゲートSiO₂膜2の上に620℃でポリシリコン3を1500Å、その上にアモルファスシリコン4を3000Å形成し、フォトレジスト5を載せたものである。

【0010】次にRIE装置で次の条件によりゲートエッチングする。

使用ガス : CCl₄ / He / O₂
= (90~100) / 350 / 20 (sccm)

圧力 : 290~360 (mTorr)

RFパワー : 120~150 (W)

電極温度 : 45~55 (℃)

図2に示すように、異方性エッチング6を受けたアモルファスシリコン4の層の側面7は垂直に、ポリシリコン3の層の側面8はテーパ形状となる。図3に示すようにポリシリコン3のテーパ形状となる幅は0.15μm程度である。

【0011】次に図4に示すように基板内の領域9内にイオン注入を行う。Nチャネル側にはAsを40KeV、5×10⁻⁵/cm²でイオン注入し、Pチャネル側にはBF₂を40KeV、5×10⁻⁵/cm²でイオン

3

注入する。ゲート電極12にも高濃度に不純物注入を行うことができ、次いでアニールすると、図5に示すようにNチャンネル側ではN⁺ソース・ドレイン10、N⁺ソース・ドレイン11が形成される。

【0012】最後に図6に示すようにゲートシリコン膜12をケミカルドライエッチにより等方エッチングし、ゲート下端の長さをソース・ドレインの低濃度側に合うようにする。エッチング部13のエッチング量は1000Åである。このようにして形成されたトランジスタは、従来のサイドウォール長0.15μmのLDDトランジスタと同等の性能をもっている。

【0013】

【発明の効果】本発明によれば、下層にはポリシリコン層、上層にはアモルファスシリコン層を形成し、これをノンドープのままドライエッチングすることによって、アモルファス層の側面は鉛直に、ポリシリコン層の側面はテーパ状となる。従って、1回のイオン注入によって、優れたLDD構造をもつドレイン領域を形成することが可能となった。

4

【図面の簡単な説明】

【図1】レジスト成形時の断面図である。

【図2】異方性エッチング工程の説明図である。

【図3】異方性エッチング工程終了時の説明図である。

【図4】イオン注入工程の説明図である。

【図5】焼鈍後の断面図である。

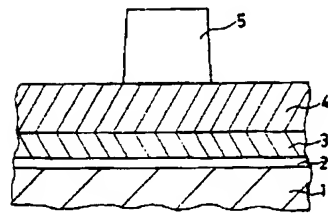
【図6】シリコンエッチング工程の断面図である。

【図7】シリコン成膜時の温度パターン図である。

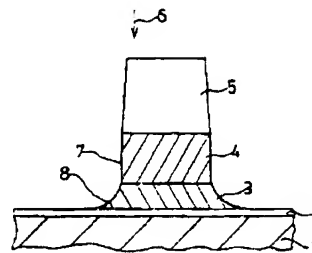
【符号の説明】

1	Si基板	2	ゲートSi
O ₂ 膜			
3	ポリシリコン	4	アモルファスシリコン
5	フォトレジスト	6	エッチング
7, 8	側面	9	領域
10	N ⁺ ソース・ドレイン	11	N ⁺ ソース・ドレイン
12	ゲートシリコン膜	13	エッチング部

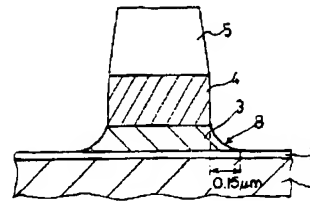
【図1】



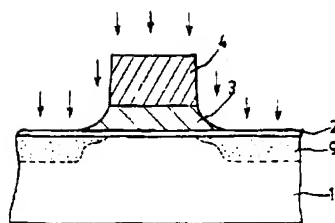
【図2】



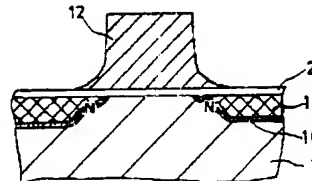
【図3】



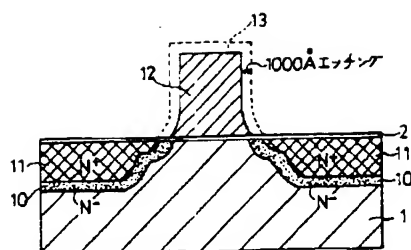
【図4】



【図5】



【図6】



【図7】

